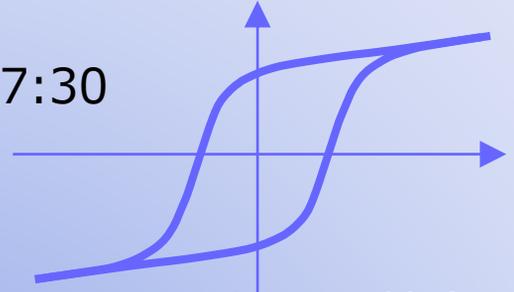


# シンポジウム

## 強誘電体材料の将来デバイスへの応用

**開催日時** 2019/9/20(金) 13:30-17:30  
**場所** C309



### 概要

強誘電体を利用した負性容量トランジスタ、FeFET、トンネル接合メモリは高速で低消費電力なデバイスを実現でき、IoTやAIへの応用が期待されています。また、強誘電体はバンドギャップ以上の光起電力を発生できることから、太陽電池への応用でも注目されています。本シンポジウムでは、強誘電体を利用したこれらの新しいデバイスを第一線で研究されている方々にご講演をいただき、今後の展開について議論を深めたいと思います。

**徳光 永輔**（北陸先端大）

強誘電体の特異な物性と強誘電体ゲートトランジスタへの応用

**小林 正治**（東大）

負性容量トランジスタの現状と将来

**森江 隆**（九工大）

FeFET応用ニューロモルフィックデバイスの現状と将来

**澤 彰仁**（産総研）

BaTiO<sub>3</sub>-FTJの抵抗変化メモリ効果と人工シナプス応用

**藤井 章輔**（東芝メモリ）

強誘電体HfO<sub>2</sub>トンネル接合メモリの現状と期待

**中村 優男**（理化学研究所）

強誘電半導体における低散逸で高速応答のシフト電流光電変換

**世話人**

齋藤真澄(東芝メモリ)、中嶋宇史(東理大)、吉村武(大阪府大)、恵下隆(代表・和歌山大学)